



1,4 - температура;

пленкой

величине степени превращения

3,6 - степень превращения;

2,5 - поток, пропущенный

можно определять по скорости роста температуры, или по

- время «зажигания» пленки

оптическими свойствами; 2 - время «зажигания» пленки

оптическими свойствами

ti

с меняющимися

с постоянными

1

фотоприемника и термопары

эксперимент

реакции		(RT)
	Простейший вариант модели для тонкой пленки:	
	$c\rho h \frac{dT}{dt} = q_{a} + Q_{ch}h \frac{d\eta}{dt} - \alpha (T - T_{0})$	(12)
	$\frac{d\eta}{dt} = z(1-\eta)^m \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$	(13)
	$\eta = T - T_0 = 0, t = 0$	(14)
	$\boldsymbol{q}_a = \boldsymbol{q}_0 \{1 - exp[-\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{h}]\}[1 - f(\boldsymbol{\eta})]$	Поток, поглощенный пленкой

 $\varphi(T,\eta) = z(1-\eta)^m \exp\left(-\frac{E_a}{2}\right)$



 $\Phi = q_0 exp[-\sigma(\eta)h][1-f(\eta)]$ Поток, пропущенный

пленкой

2.б Усложним задачу

Скорость химической

Разложение полимеров, как правило, протекает в две основные стадии. Первая – эндотермическая. Именно она сопровождается образованием поглощающих центов. Вторая – экзотермическая, связана с превращением продукта первой стадии с участием газовой фазы





«время зажигания» широким потоком $t_{i\infty}$

Оболочка, охлаждаемая излучением, с резким перепадом равновесных температур

Рассмотрим задачу о нахождении установившегося распределения температуры в окрестности стыка двух материалов (рисунок), которая возникает при изучении теплообмена оболочки летательного аппарата



Если условия теплообмена на поверхности тонкостенной оболочки изменяются медленно, то передачу тепла теплопроводностью вдоль нее можно не учитывать. В этом случае установившиеся температуры каждой части такой оболочки можно рассчитывать независимо

$$T_1, T_2$$
 – равновесные температуры $T_2 < T < T_1$ - в окрестности стыка

y

y



$$\lambda_i \left[\frac{\partial^2 T_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_i}{\partial y^2} \right] = 0$$
$$= 0 \qquad \qquad \frac{\partial T_i}{\partial y} = 0$$
$$= h_i \qquad -\lambda_i \frac{\partial T_i}{\partial y} = \varepsilon_i \sigma_0 \left[T_i^4 - T_{ie}^4 \right]$$

Так как оболочки – тонкие, проинтегрируем уравнения теплопроводности по толщине с учетом граничных условий



 $\delta < 1$ Внутри пучка образуются «волновые структуры» («широкий пучок»). Вслед за фронтом превращения к границам пучка распространяются волны поглощения и просветления

Обнаружено явление самофокусировки, вызванное увеличением поглощения излучения в области с наибольшей степенью превращения в твердой фазе

В результате найдем:

$$\int_{0}^{h_{i}} \lambda_{i} \frac{\partial^{2} T_{i}}{\partial x^{2}} dy + \lambda_{i} \frac{\partial T_{i}}{\partial y} \Big|_{0}^{h_{i}} = \lambda_{i} h_{i} \frac{d^{2} T_{i}}{dx^{2}} - \varepsilon_{i} \sigma_{0} \Big[T_{i}^{4} - T_{ie}^{4} \Big] = 0$$

Условиями к двум уравнениям теплопроводности будут:

$$\begin{array}{ll} x \rightarrow -\infty & T_1 = T_{1e} & {}^{\scriptscriptstyle \rm ИЛИ} & dT_1/dx = 0 \\ x \rightarrow +\infty & T_2 = T_{2e} & {}^{\scriptscriptstyle \rm ИЛИ} & dT_2/dx = 0 \\ x = 0 & T_1 = T_2 & \lambda_1 h_1 \frac{dT_1}{dx} = \lambda_2 h_2 \frac{dT_2}{dx} \end{array}$$

Эта задача, не смотря на нелинейный характер, легко интегрируется

Вводим
обозначения
$$\frac{dT_i}{dx} = p_i \longrightarrow \lambda_i h_i \frac{dp_i}{dT_i} \frac{dT_i}{dx} = \varepsilon_i \sigma_0 \Big[T_i^4 - T_{ie}^4 \Big]$$
 или
 $\lambda_i h_i p_i dp_i = \varepsilon_i \sigma_0 \Big[T_i^4 - T_{ie}^4 \Big] dT_i$
 $\frac{1}{2} \lambda_i h_i p_i^2 = \varepsilon_i \sigma_0 \Big[\frac{1}{5} T_i^5 - T_{ie}^4 T_i + D_i \Big], \quad i = 1, 2$

Постоянные интегрирования находим из граничных условий

$$D_1 = \frac{4}{5}T_{1e}^5, D_2 = \frac{4}{5}T_{2e}^5$$

Из условия в нуле получим уравнения для определения температуры на контакте материалов

 $T_1 = T_2 = T_0$

 $p_1 = \frac{\lambda_2 h_2}{\lambda_1 h_1} p_2$, $p_1^2 = \left(\frac{\lambda_2 h_2}{\lambda_1 h_1}\right)^2 p_2^2$

Так как

то найдем



После того как температура на контакте определена, уравнения теплопроводности решаются независимо

Можно построить приближенное решение, используя линеаризацию:

$$\frac{d^{2}T_{i}}{dx^{2}} = \frac{\varepsilon_{i}\sigma_{0}}{\lambda_{i}h_{i}} \Big[T_{i}^{4} - T_{ie}^{4} \Big] = \frac{\varepsilon_{i}\sigma_{0}}{\lambda_{i}h_{i}} (T_{i} - T_{ie}) \Big[T_{i}^{3} + T_{i}^{2}T_{ie} + T_{i}T_{ie}^{2} + T_{ie}^{3} \Big] \approx$$
$$\approx \left(\frac{N_{i0}}{h_{i}} \right)^{2} (T_{i} - T_{ie}),$$
$$N_{i0}^{2} = \frac{\varepsilon_{i}\sigma_{0}h_{i}}{\lambda_{i}} \Big[T_{0}^{3} + T_{0}^{2}T_{ie} + T_{0}T_{ie}^{2} + T_{ie}^{3} \Big]$$
$$\frac{T_{i} - T_{ie}}{T_{0} - T_{ie}} = \exp \left[-\frac{N_{i0}x}{h_{i}} \right]$$

Взаимодействие электронов с веществом

При взаимодействии потоков ускоренных электронов с поверхностью твердого тела происходит ряд процессов, которые могут быть использованы как для целей технологии, так и в методах анализа свойств твердого тела.

Эти процессы разделяются на упругие и неупругие. При упругих процессах не происходит изменение энергии электронов, а происходит лишь изменение импульса. При неупругом взаимодействии меняется и энергия электронов.

Нагрев образца используется при электронно-лучевой плавке, отжиге, сварке, испарении.

Стимуляция химических реакций, например, при реактивном электронно-лучевом осаждении пленок.

Ряд физических эффектов нашел применение в аналитических методах исследования твердых тел и их поверхностей.

В случае электронного облучения поглощение энергии зависит только от энергии налетающих электронов Е (кэВ) и атомного номера Z (от углерода до олова, т.е. от 6 до 50) вещества мишени. В первом приближении профиль поглощенной энергии может быть аппроксимирован распределением Гаусса

 $q = q_0 \exp\left(-(x - X_p)^2 / 2\sigma^2\right)$ $X_p = (0,143Z + 0,633)r_0, \quad \sigma = (-0,0538\ln Z + 0,374)r_0$ $r_0 = AE^{\alpha}, \quad \Gamma/CM^2$



Сущность процесса электронно- лучевого воздействия заключается в преобразовании кинетической энергии электронного пучка в тепловую энергию в зоне обработки. Главными особенностями электронно- лучевой обработки материалов являются:

-возможность выделения в малом объеме значительной энергии (10³ - 10⁸ BT/см²); -чистота воздействия, чему способствуют также и необходимые вакуумные условия; -относительная простота управления параметрами пучка (существует возможность автоматизации процесса).















В результате наплавки образуется либо полностью гомогенное покрытие, представляющее собой твердый раствор; либо композит, в котором нерастворившиеся частицы внедрены в твердый раствор, состав которого определяется в процессе решения. В экспериментальных исследованиях (хотя и на более сложных системах) также обнаруживаются области технологических параметров, приводящие к полному или частичному растворению дисперсной фазы, что подтверждает адекватность модели.

Теплофизическая модель процесса кислородной резки

Кислородная резка основана на способности многих металлов воспламеняться при температуре, ниже температуры его плавления, и интенсивно сгорать с выделением значительного количества тепла. Важными параметрами технологического процесса являются скорость перемещения режущей струи по поверхности детали, скорость газа в струе, ее ширина, определяющая характерный размер области прогрева разрезаемого материала.

$$hc\rho\frac{\partial T}{\partial t} = h\lambda \left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\right] - \alpha_{eff}(T - T_e) + q(t)exp\left[-\alpha^2 \left(y^2 + (x - Vt)^2\right)\right] + Q\frac{\partial h}{\partial t}$$
(41)

$$\begin{cases} \frac{\partial h}{\partial t} = -\frac{k_0 \exp\left[-E/RT\right]}{1+k_0\beta_0^{-1}\exp\left[-E/RT\right]} \equiv -\frac{k\beta_0}{k+\beta_0} = -\phi(T), \quad h \neq 0$$
(42)

$$\frac{\partial h}{\partial t} = 0, \quad h = 0$$

$$\mathbf{x} = 0, \mathbf{h}_{\mathbf{x}} : \lambda \frac{\partial T}{\partial \mathbf{x}} = 0; \quad \mathbf{y} = 0, \mathbf{h}_{\mathbf{y}} : \lambda \frac{\partial T}{\partial \mathbf{y}} = 0$$
(43)

$$t = 0$$
: $T(x, y, 0) = T_0$; $h(x, y, 0) = h_0$ (44)

При взаимодействии кислородной струи с разрезаемым материалом протекают сложные физико-химические, тепловые и механические процессы, определяющие форму и фазовый и химический состав края реза.

Следствием неоднородного состава является и неоднородность модуля упругости вдоль координат, неоднозначно зависящая от технологических параметров в случае растворимых частиц.



В общем случае требуется определить условия, необходимые для начала процесса резки, и исследовать возможные режимы процесса после его выхода на квазистационарный режим, что может быть использовано в дальнейшем для постановки задачи оптимизации.





